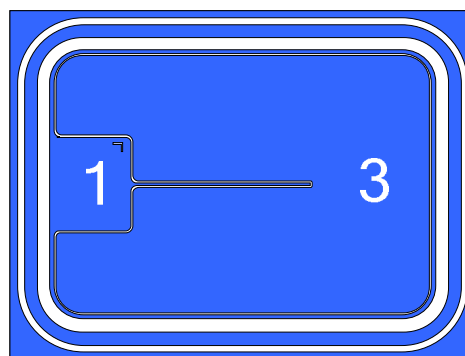


3VD235600YL 高压MOSFET芯片

描述

- 3VD235600YL为采用硅外延工艺制造的N沟道增强型600V高压MOS功率场效应晶体管；
- 先进的高压分压终止环结构；
- 较高的雪崩能量；
- 漏源二极管恢复时间快；
- 该芯片可采用TO-251型式封装，典型的成品规格为2N60；
- 封装后的成品广泛应用于AC-DC开关电源，DC-DC电源转换器，高压H桥PWM马达驱动；



1-Gate PAD 3-Source PAD

芯片简图

芯片介绍

项 目	描 述
圆片尺寸	6Inch
管芯尺寸	2060μm *2720μm
管芯数量	2815 dice/wafer
芯片厚度	300±20μm.
正面金属 / 厚度	Al(1%Si) : 3μm.
背面金属 / 厚度	Ti/Ni/Ag:0.1/0.3/0.4μm
栅极压点尺寸 (PAD1)	454.2μm *536μm
划片道宽度	80μm *80μm

极限参数(Tamb=25℃)

参数名称	符号	额定值	单位
漏源电压	VDS	600	V
栅源电压	VGS	±30	V
漏极电流	ID	2.0	A
耗散功率(TO-251 封装)	PD	44	W
工作结温	TJ	150	℃
贮存温度	Tstg	-55~+150	℃

电参数(T_{amb}=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BVDSS	VGS=0V, ID=250μA	600	-	-	V
栅极开启电压	VTH	VGS= VDS, ID=250μA	2.0	-	4.0	V
漏源漏电流	IDSS	VDS=600V, VGS=0V	-	-	1.0	μA
导通电阻	RDS(on)	VGS=10V, ID=1.0A	-	-	4.6	Ω
栅源漏电流	IGSS	VGS=±30V, VDS=0V	-	-	±100	nA
漏源寄生二极管正向导通压降	VFSD	IS=2.0A, VGS=0V	-	-	1.4	V

声明:

- 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!